

a 2003 0081

Invenția se referă la optoelectronică, în particular la procedee de obținere a cristalelor fotonice.

Procedeul de obținere a cristalului fonic include depunerea unei măști pe una din suprafețele cristalului de semiconductor sau de dielectric, totodată masca este executată în formă de grilă cu orificii amplasate în rânduri cu pași egali, apoi are loc implantarea ionilor de energie înaltă în fiecare orificiu al măștii în patru direcții și decaparea electrochimică. Noutatea invenției constă în faptul că la implantare fiecare direcție a ionilor formează un unghi de 45° față de normală la suprafața cristalului, iar unghiurile dintre direcțiile ionilor sunt egale cu 90° .

Revendicări: 1

Figuri: 1